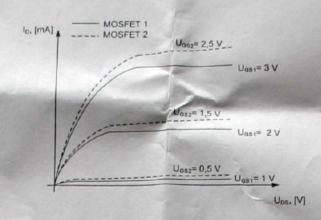
15.12.2006.

PRVA SKUPINA ZADATAKA

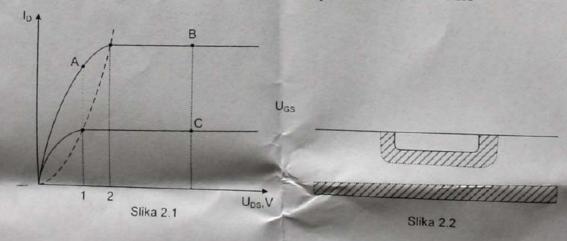
1.



- 1-1. Na slici su prikazane izlazne karakteristike 2 različita MOSFET-a. Sa U_{GSI} su označeni naponi 1. MOSFET-a, a sa U_{GS2} su označeni naponi 2. MOSFET-a. Oba tranzistora imaju iste dimenzije W i L. Za prikazane MOSFET-e vrijedi (1bod):
 - a. oba MOSFET-a su n-tipa i obogaćeni, pri čemu MOSFET 1 ima manji napon praga od MOSFET-a 2,
 - b. oba MOSFET-a su p-tipa, pri čemu je MOSFET 1 je obogaćen a MOSFET 2 osiromašen i MOSFET 1 ima veći napon praga od MOSFET-a 2,
 - c. oba MOSFET-a su n-tipa, pri čemu je MOSFET 1 je osiromašen a MOSFET 2 obogaćen i MOSFET 1 ima veći napon praga od MOSFET-a 2,
 - d. oba MOSFET-a su p-tipa i obogaćeni, pri čemu MOSFET 1 ima manji napon praga od MOSFET-a 2,
 - © oba MOSFET-a su n-tipa i obogaćeni, pri čemu MOSFET 1 ima veći napon praga od MOSFET-a 2.

1-2. Za dinamičke parametre tranzistora vrijedi (1bod):

- a. MOSFET 1 ima manju strminu i manji izlazni dinamički otpor od MOSFET-a 2,
 - b. MOSFET 1 ima veću strminu i manji izlazni dinamički otpor od MOSFET-a 2,
 - c. Jednaki su,
 - d. MOSFET 1 ima veću strminu i veći izlazni dinamički otpor od MOSFET-a 2,
- e. MOSFET 1 ima manju strminu i veći izlazni dinamički otpor od MOSFET-a 2.
- 2. Izlazne karakteristike JFET-a koji ima napon dodira iznosa 3V prikazane su na slici 2.1



- 2-1. Kojoj točki odgovara oblik kanala prikazan na slici 2.2 i kolíki je napon U_{GS} u toj točki (1bod):
 - a. A,-2V
 - b. B,-1V
 - c. B,+1V
 - d. A,-1V
 - e. A,+1V

- 2-2. Za strmine i dinamičke otpore u točkama B i C vrijedi odnos (1bod):
 - a. gmB \gmc, rdB > rdc
 - b. gmB Smc, rdB rdC
 - c. $g_{mB}=g_{mC}$, $r_{dB}=r_{dC}$
 - d. $g_{mB} > g_{mC}$, $r_{dB} = r_{dC}$
 - e. gmB gmc, rdB rdc

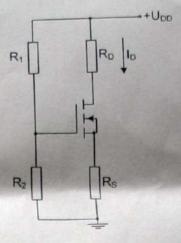
3. U sklopu pojačala na slici struja I_D je opisana jednadžbom $I_D = K/2 \cdot (U_{GS} - U_{GSO})^2 \cdot (1 + \lambda \cdot U_{DS})$.

3-1. Što će se dogoditi sa strujom I_D ako se R_S poveća (1bod):

- a. ID pada pa raste,
- b. ID raste pa pada,
- c. In raste,
- (d) ID pada,
- e. ID ostaje ista.

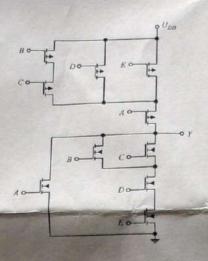
3-2. Što će se dogoditi sa strujom I_D ako se R_D smanji (1bod):

- (a) ID ostaje ista,
- b. ID pada pa raste,
- c. ID raste pa pada,
- d. ID raste,
- e. ID pada.

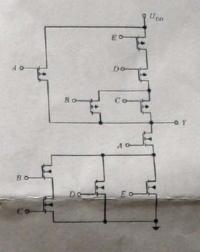


4. Koju logičku funkciju ostvaruje CMOS sklop na slici?

4-1. (1bod)



4-2. (1bod)



Odgovor:

a.
$$Y = \overline{A(BC + D + E)}$$

b.
$$Y = A + (B+C)DE$$

c.
$$Y = \overline{A + (B + C)DE}$$

d.
$$Y = A(BC + D + E)$$

e. niti jedan od odgovora

Odgovor:

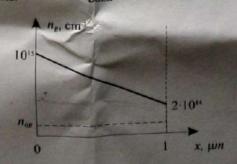
a.
$$Y = \overline{A + (B + C)DE}$$

c.
$$Y = A + (B+C)DE$$

d.
$$Y = A(BC + D + E)$$

e.
$$Y = \overline{A(BC + D + E)}$$

5-1. Na slici je zadana koncentracija manjinskih nositaca u bazi. U kojem području rada je tranzistor (1bod):



- a. zasićenja
- b. inverzno aktivno
- c. ne može se odrediti
- d. normalno aktivno
- e. zaporno

- 5-2. Za raspodjelu manjinskih nosilaca danu na gornjoj slici ukupni nakrcani naboj manjinskih nosilaca u bazi (po jedinici površine) je (1bod):
 - 1 nAs/cm2 b.) 11,8 nAs/cm²
 - 6,4 nAs/cm²
 - 9,6 nAs/cm²
 - 3,2 nAs/ cm²

DRUGA SKUPINA ZADATAKA

ZADATAK.1. Prijenosna karakteristika nekog MOSFET-a prikazana je na slici. Pretpostaviti λ=0. Odrediti:

- 1-1. tip MOSFET-a (1bod)
- 1-2. strminu u točki A (1bod)
- 1-3. strujnu konstantu MOSFET-a K (1bod)
- 1-4. struju u točki B (1bod)
- 1-5. strminu i dinamički otpor u točki B (1bod)

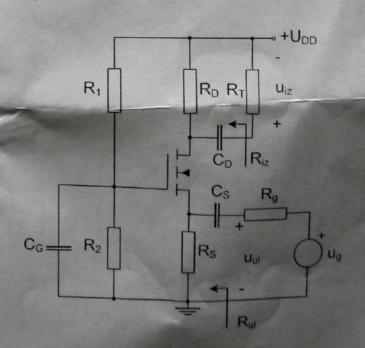
Odgovori:

- 1-1. (1bod)
 - a. p-kanalni obogaćeno-osiromašeni tip
 - b. n-kanalni, osiromašeni tip
 - (c.) n-kanalni, obogaćeni tip
 - d. p-kanalni, obogaćeni tip
 - e. p-kanalni, osiromašeni tip
- 1-3. (1bod)
 - a. $K=1,78 \text{ mA/V}^2$
 - b. $K=0.22 \text{ mA/V}^2$
 - $K=197 \, \mu \text{A/V}^2$
 - $K=0,44 \text{ mA/V}^2$
 - $K=0.75 \text{ mA/V}^2$
- 1-4.
- (1bod)
- $I_{DB} = 1,11 \text{ mA}$
- $I_{DB} = 1.98 \text{ mA}$
- c. IDR=0,55 mA
- d. IDB=1,54 mA
- $I_{DB} = 1.25 \text{ mA}$

- Ip, [mA] Ups=2 V 0.5 0,75 2,25 Ugs. [V]
- 1-2. (1bod)
 - $g_{mA}=1,33 \text{ mA/V}$ $g_{mA} = 0,67 \text{ mA/V}$
 - $g_{mA}=1 \text{ mA/V}$
 - d. $g_{mA} = 0.33 \text{ mA/V}$
 - $g_{mA} = 0,44 \text{ mA/V}$
 - 1-5. (1bod)
 - a.
- g_{mB} =0,75 mA/V, r_{dB} =12,5 k Ω g_{mB} =0,89 mA/V, r_{dB} =9 k Ω
- $g_{mB}=1,2 \text{ mA/V}, r_{dB}=\infty$
- $g_{mB}=1,2 \text{ mA/V}, r_{dB}=9 \text{ k}\Omega$ d.
- $g_{mB}=0.89 \text{ mA/V}, r_{dB}=\infty$

ZADATAK.2. Za pojačalu sa slike zadano je: L_{QD} =15 V, R_g =500 Ω , R_I =3,9 M Ω , R_Z =1,5 M Ω , R_D =2,7 k Ω i R_T =5,6 k Ω . Parametri n-kanalnog MOSFET-a suK=2,2 mA/VJ, $U_{GS0}=1,05$ V i $\lambda=0,0039$ V⁻¹.

- 2-1. Odrediti vrijednost otpornika Rs, ako je poznata struja I_{DO} =2,41 mA. (1bod)
- 2-2. Odrediti dinamičke parametre g_m i r_d , ako je poznato $(I_{DQ}=2,74 \text{ mA})$ $U_{DSQ}=6,05 \text{ V}$, $U_{GSQ}=2,63 \text{ V}$, i $R_s=560 \Omega$.
- 2-3. Odrediti naponsko pojačanje $A_1=u_{iz}/u_{ul}$, ako su poznati dinamički parametri $g_m=3,75$ mA/V i $r_d=83,4$ k Ω , te $R_S=470 \Omega$. (1bod)
- 2-4. Odrediti ulazni otpor Rul, ako su poznati dinamički parametri $g_m=3,75$ mA/V i $r_d=83,4$ k Ω , te $R_s=470$ Ω . (1bod)
- 2-5. Odrediti izlazni otpor Riz, ako su poznati dinamički parametri $g_m=3.75$ mA/V i $r_d=83.4$ k Ω , te $R_S=470$ Ω . (1bod)



Odgovori:

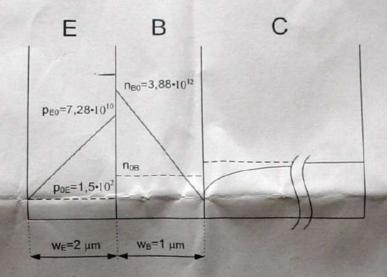
2-1.

a. R_S =470 Ω b. R_S =560 Ω c. R_S =390 Ω d. R_S =820 Ω e. R_S =680 Ω 2-3. (1bod) a. A_V =-8,474 b. A_V =-7,356 c. A_V =6,585 d. A_V =8,474 e. A_V =-6,585

(1bod)

2-2. (1bod) a. $g_m = 5,63 \text{ mA/V}$, $r_d=57,18 \text{ k}\Omega$ b. $g_m = 2,49 \text{ mA/V}$, $r_d=93,46 \text{ k}\Omega$ c. $g_m = 3,56 \text{ mA/V}$, $r_d=93,46 \text{ k}\Omega$ d. $g_m = 5,63 \text{ mA/V}$, $r = 39,54 \text{ k}\Omega$ e. $g_m = 3,56 \text{ mA/V}$, $r_d=39,54 \text{ k}\Omega$ 2-4. 2-5. (1bod) (1bod) a. $R_{tz}=3011\Omega$ $R_{\rm w}=172,5\Omega$ $R_{uf} = 202.8\Omega$ b. $R_{iz} = 2655\Omega$ $R_b = 1752\Omega$ $R_{\nu}=345\Omega$ $R_i = 2004\Omega$ d. $R_{\nu} = 132,2\Omega$ $R_{u}=272,5\Omega$ e. $R_{iz}=1101\Omega$

ZADATAK.3. Raspodjele manjinskih nosilaca bipolarnog tranzistora za neku radnu točku prikazane su na slici. Poznate su pokretljivosti nosilaca μ_n =550 cm²/Vs, μ_p =250 cm²/Vs te površina spoja baza-emiter S=5 mm². U radnoj točki rekombinacijska struja baze iznosi I_R =10 μ A. Pretpostaviti U_T =25 mV.



- 3-1. Odrediti tip tranzistora i područje rada (1 bod)
- 3-2. Odrediti napon na spoju baza-emiter (1 bod)
- 3-3. Odrediti struju emitera (1 bod)
- 3-4. Odrediti struju baze (1 bod)
- 3-5. Odrediti faktor β uz pretpostavku da su iznosi struja tranzistora $|I_E|$ =2 mA i $|I_C|$ =1,99 mA (ovaj dio nije vezan uz prethodne dijelove zadatka). (1bod)



- 3-1.
- (1bod)
 a npn u normalnom aktivnom području
 b. pnp u inverznom aktivnom području
- c. pnp u normalnom aktivnom području
- d. npn u inverznom aktivnom području
- e. npn u području zasićenja
- 3-3. (1bod)
 - a. $I_E = -42.9 \, \mu A$
 - b. I_E =4,2862 mA
 - (c.) $I_E = -4,250 \text{ mA}$ d. $I_E = -4,2862 \text{ mA}$
 - e. I_E =4,250 mA

- 3-4.
 - 4. (1bod)
 - a. $l_{\beta}=10 \,\mu\text{A}$
 - (6) $I_B = 28,2 \, \mu A$
 - c. $I_B = -28.2 \,\mu\text{A}$ d. $I_B = 18.2 \,\mu\text{A}$
 - e. $I_B = -18,2 \, \mu A$

- 3-2. (1bod)
 - a. $U_{BE}=0,55 \text{ V}$
 - b. $U_{BE}=0,6 \text{ V}$
 - c. $U_{BE}=0,5 \text{ V}$
 - d. $U_{BE}=0,575 \text{ V}$
 - e. $U_{BE}=0.7 \text{ V}$
 - 3-5. (1bod)
 - a. β=0,99
 - b. β=99
 - c. β=0,995d. β=201
 - d. β=201 (e.) β=199